



NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

*2013年3月11日に発表されたプレスリリースの抄訳です

タワージャズ、GaAs（ガリウム砒素）の代替となる Silicon Radio Platform で数十億ドル規模のフロントエンドモジュール(FEM)市場のシェアを大幅に拡大

50件を超えるデザインウインで顧客を拡大：タワージャズが数十億ドル規模の FEM 市場でデバイスの中核となる製品の製造態勢を備える

ハンドセット FEM 市場は 2017 年までに倍増し 100 億ドル規模になると予測

イスラエル ミグダルハエメク、カリフォルニア州 ニューポートビーチ 2013年3月11日 – スペシャルティファンドリの世界的リーダーであるタワージャズは本日、重要顧客との契約および急成長中のフロントエンドモジュール(FEM)市場で、スマートフォンやその他モバイル機器向けの Silicon Radio Platform (SRP)によるシェアの獲得を発表しました。タワージャズの SRP はアンテナスイッチ、アンテナチューナー、ダイバシティ スイッチ、コントローラ、ローノイズアンプ(LNA)、パワーアンプ(PA)などモバイル機器に搭載される無線を統合し、高価なディスクリット GaAs デバイスの必要性を解消しつつあります。この SRP は、統合制御と MIPI(Mobile Industry Processor Interface)のインターフェイス機能向けに、最先端の RF SOI 技術と SiGe PA 技術を 0.18um RF CMOS プロセスで使用します。

タワージャズの最新の RF SOI 技術は、アンテナスイッチやアンテナチューナー製品での性能指数 $R_{on} - C_{off} = 217fs$ という業界でも最高水準の特性を持っています。この技術は GaAs 実装からの迅速な代替が可能で、既に世界中で多くのお客様に採用されており、50 件を超えるデザインウインでテープインがあり、初期設計から生産立ち上げまでを行っています。

タワージャズのシリコンゲルマニウム (SiGe) PA プロセスは、0.18um 技術でパワーアンプ、コントローラ、MIPI インターフェイスの効果的な統合が可能になり、40%のコストで GaAs の

それに匹敵する性能を発揮するシリコン貫通ビア技術も使用し、それまでは不可能だった新しいチューニング特徴と統合レベルを実現しています。

経済性と性能への注目により GaAs 技術から Si や SiGe 技術への移行は、今後数年にわたりタワージャズにとって FEM 市場において 3 倍以上のシェアが期待でき、またタワージャズもこの急成長する数十億ドル規模の市場の中核となる製品を製造する態勢を整えています。Mobile Experts, LLC の 2012 年のレポートによると、携帯機器のフロントエンド市場は倍増し 100 億ドルになると予測され RF パスの数も 2017 年までに 200 億まで伸びるだろうとされています。さらに、このレポートではマルチモード、マルチバンドハンドセットおよび MIMO (multiple-input and multiple-output) がモバイル機器向け RF コンポーネントの出荷数を驚異的に拡大させることを示唆しています。

FEM 市場の成長を牽引する要因としては、802.11a/b/g/n/ac、近距離無線通信 (NFC)、GPS、Bluetooth、ZigBee、HSPA+、LTE などあらゆるところから接続ができるようになったこと、モバイルプラットフォームにおける通信可能範囲や利用できるウェブコンテンツの拡大、そしてスマートエナジー、パワー・マネジメント、車載用新規分野などのアナログ市場の出現があげられます。そしてタワージャズはこれらの市場に取り組みながらさらに 3 つのメガトレンドに向けたビジネスチャンスを狙っています。(1) Green Everything (環境への配慮)、(2) Wireless Everywhere (どこでもワイヤレス通信が可能)、(3) Smart Everything (スマート化) これらは私達の日常生活とコンシューマーエレクトロニクスを発展させていくものです。

タワージャズの最高経営責任者 Russell Ellwanger は次のように述べています。「ムーアの法則の減速と相まって、これらのメガトレンドはタワージャズが提供するシステムレベルのパフォーマンスの最適化に向けたさらなる差別化と機会創出に繋がるアナログ、RF、SiGe、パワー、MEMS、CMOS イメージセンサのようなスペシャルティテクノロジー分野でさらなるチャンスをもたらします。デジタルとアナログ両方の技術を習得することにより、タワージャズは、FEM 市場において発揮しているリーダーシップでも象徴されているように、このトレンドをうまく活用しこの市場でのより急速な成長に向けて独自のポジションを確立しています。」

タワージャズは、ワールドクラスのデザイン設計とあわせて最高のスペシャルティプロセステクノロジーを提供し、お客様それぞれのモバイルアプリケーション向けに差別化された製品を作り出すために必要なツール、テクノロジー、サポートサービス、柔軟性を備えています。タワージャズは、コントローラ向け RF CMOS、スイッチおよびアンテナチューナー向け SOI、WLAN やセルラー PA 向け SiGe、信号処理用高性能受動素子向け IPD (集積型パッシブデバイス)、複雑なパワーマネジメントチップに使われる BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) など様々なアプリケーションに対応するプラットフォームも数多くそろえています。タワージャズの MEMS ソリューションは、これらのテクノロジーにおいて強力なパートナーシップを確立できる独自

のツールセットとファンドリモデルを提供しています。タワージャズのデザインイネーブルメントは PDK、モデリング、初期デザインにおける製品動作の達成と市場投入までの最短化ツールなど、動きの速い携帯市場に必要なサービスを提供しています。

タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE: TSEM)は、米国にある完全子会社ジャズセミコンダクター社、日本にある完全子会社タワージャズジャパン株式会社とともに、タワージャズというブランド名でグローバルに事業展開するスペシャルティファンドリのリーダーです。タワージャズは 1.0 から 0.13 ミクロンのプロセスノードで集積回路を生産し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル、RFCMOS、CMOS イメージセンサ、パワーマネージメントパワーマネージメント (BCD)、不揮発性メモリ (NVM)、CMOS、MEMS など、幅広いカスタマイズが可能なプロセス技術を提供しています。また洗練された技術で迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントプラットフォームも提供します。さらに、IDM やキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業、R&D から生産を進める企業向けのプロセス移管サービス(TOPSTM)も提供します。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワージャズは 3 大陸にまたがり生産拠点を有することでグローバルなキャパシティを確保しており、イスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国と日本に各 1 か所(200mm)のファブに加え、中国の生産施設ともパートナーシップを提携しています。詳細は www.towerjazz.com をご覧ください。

Company/Media Contact in US: Lauri Julian | +1 949 435 8181 | lauri.julian@towerjazz.com

Investor Relations Contact: Noit Levi | +972-4-604-7066 | noit.levi@towerjazz.com